2SD1506

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor

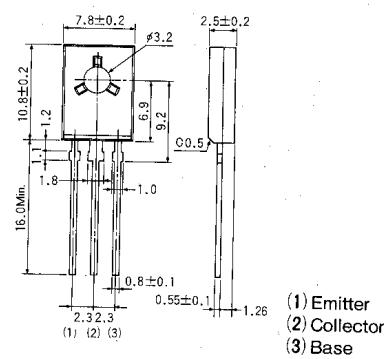
● 特長

1) $V_{CE(sat)}$=0.5V (Typ.) と低い。
(at I_C/I_B=2A/0.2A)
2) ASOが広く破壊に強い。
3) 2SB1065とコンプリである。
4) 放熱器への取付けが容易にできる。

● Features

1) Low collector saturation voltage:
$V_{CE(sat)}$=0.5V (Typ.) I_C/I_B=2A/0.2A
2) ASO is wide and resistant to breakdown.
3) Complementary pair with 2SB1065.
4) Easy installation into radiators.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



TO-126

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	3	A
		4.5	A(Pulse)
コレクタ損失	P_C	10	W(Tc=25°C)
		1.2	W(Ta=25°C)
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度範囲	T_{stg}	−55～150	°C

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	50	—	—	V	I_C=1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	60	—	—	V	I_C=50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E=50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	1.0	μA	V_{CB}=40V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	1.0	μA	V_{EB}=4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	I_C/I_B=2A/0.2A
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	I_C/I_B=2A/0.2A
直流電流増幅率	h_{FE}	56	—	390	—	V_{CE}/I_C=3V/0.5A
利得帯域幅積	f_T	—	90	—	MHz	V_{CE}=5V, I_E=−0.5A
出力容量	C_{ob}	—	40	—	pF	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	N	P	Q	R
h_{FE}	56～120	82～180	120～270	180～390

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク
		記号	
		基本発注単位(個)	1 000
2SD1506	NPQR		○